

Beynəlxalq Konfrans "Fizika-2005" International Conference "Fizika-2005" Международная Конференция "Fizika-2005"

İyun June 2005 Июнь

005

səhifə №200 page 762-765 стр.

Bakı, Azərbaycan

Baku, Azerbaijan

Баку, Азербайджан

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ EuGa₂S₄ :Er

КАЗЫМОВА Ф.А.¹, ТАГИЕВ Б.Г.¹, БЕНАЛОУЛ П.², БАРТОУ С.², ТАГИЕВ О.Б.¹, АБУШОВ С.А.¹, АБДУЛЛАЕВА З.Я.

¹Институт Физика Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку. E-mail: <u>azepl@physics.ab.az</u>

²Франция, Париж F-75252, Университет им.П.и М.Кюри, CNRS-UMR 7601, лаборатория оптика твердого тела

В нелегированных и легированных Er^{3+} кристаллах $EuGa_2S_4$ в области температур 77-450К исследованы термолюминесценция и фотолюминесценция. Термолюминесценция исследована при различных скоростях нагрева и уровнях возбуждения. Показано, что с увеличением скорости нагрева интенсивность спектра термолюминесценции растет и максимумы смещаются в область высоких температур. В легированных эрбием кристаллах наблюдается стоксовая и антистоксовой люминесценция. Установлены механизмы стоксовой и антистоксовой люминесценции.

1.ВВЕДЕНИЕ

Эрбий (Ег) является трехвалентным редкоземельным элементом (РЗЭ) и обладает излучательными переходами в видимой (500-750нм) и инфракрасной (ИК) областях спектра (900-1600нм). Поведение Ег исследуется в различных матрицах. Целью этих исследований является выявление эффективных центров излучения как в видимой, так и в ИК областях спектра. Особый интерес представляет излучение Ег³⁺ в различных матрицах, обусловленное внутрицентровыми переходами 4f электронов в области (1530-1560нм) для оптической связи. Материалы, содержащие Ег³⁺, могут с успехом использоваться для изготовления планарных оптических усилителей или лазеров. Эти элементы интегрируются с телекоммуникационными системами.

В широкозонных материалах, какими является соединения с общей формулой $M^{II}M_2^{III}X_4$ (M^{II} - двухвалентные катионы Eu, Sm, Yb,Ca, Sr, Ba и др. M^{III} -трехвалентные катионы Ga, Al, İn; X-халькогены S, Se, Te, O), наряду ИК излучением, наблюдается эффективная люминесценция в видимой области [1].

Усиление передачи энергии между сенсибилизатором и активатором можно добиться уменьшением расстояния между ними. Для этой цели подходящей матрицей является соединение $EuGa_2S_4$. Введение Er^{3+} в $EuGa_2S_4$ создает благоприятное условие для передачи энергии от Er^{3+} иона к Eu^{2+} иону, и наоборот.

В настоящей работе приводятся результаты исследований термолюминесценции (ТЛ) и фотолюминесценции (ФЛ) в кристаллах $EuGa_2S_4:Er^{3+}$. Известно, что исследование ТЛ в люминесцентных

материалах позволяет определить важнейшие параметры ловушечных уровней (энергия активации, сечения захвата, частотный фактор и др.), играющие решающую роль в появлении временной зависимости интенсивности люминесценции.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.

Соединение EuGa₂S₄:Ег синтезировалось твердотельной реакцией бинарных соединений EuS, Ga₂S₃ и ErF₃, взятых в стехиометрических соотношениях в эвакуированных до 10^{-4} мм.рт.ст. кварцевых ампулах. Концентрация ионов Er³⁺ составляла 1,5 и 7 мол %. Смеси порошков сульфидов европия (EuS), галлия (Ga₂S₃) и фторида эрбия (ErF₃) в атмосфере серы выдерживались при температуре 1200К в течение 5-7 часов. Затем температура указанной смеси уменьшалась до 1000К, при которой в течение одного часа производился отжиг.

ТЛ исследована по методике, описанной в [2]. Образцы возбуждались ртутной лампой ПРК4 при температуре жидкого азота. Блок схема установки для измерения ТЛ представлена на рис.1.

Эта установка позволяет преобразовать энергию люминесценции образца при его нагревании в электрическую энергию. Усиленный сигнал передавался на двухкоординатный потенциометр. Криостат термолюминографа 1 состоит из узла вывода образца 2 и термопары 3; узла выхода 5 света от образца в процессе термолюминесценции; канала для циркуляции жидкого азота и нагревательного элемента 4. Свечение регистрируется с помощью фотоэлектронного умножителя 6. Световой сигнал от образца, преобразованный фотоумножителем в электрический, усиливается усилителем постоянного тока 7, а затем записывается на ленту электронного потенциометра 8.



Рис.1. а) Схема блока регистрации термолюминесценции. б) Схема термолюминографа ТЛГ-69М.

Температура образца регистрировалась термопарой мед-константан. Расхождения между показаниями измерительной термопары и показаниями термопары, помещенной в центре образца, менее 1 град. Величина ЭДС термопары регистрировалась электронным потенциометром 8.

Для исследования ФЛ образцов EuGa₂S₄:Er использовали азотный импульсный лазер (Laser Photonics LN 1000, 1.4 mJ energy per pulse, pulse width 0,6ns) или лазер на красителях (Laser Photonics LN 102, conmarine 420). Длина волны импульсного азотного лазера равны 337, 1 нм, а лазера на красителях 420нм. Методика исследования ФЛ образцов EuGa₂S₄:Er³⁺ подробно описана в [1].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Спектры ТЛ и ФЛ образцов EuGa₂S₄:Er³⁺ представлены на рис.2 и рис.3. ТЛ образцов активированных (EuGa $_2S_4{:}{\rm Er}^{3^+})$ и нелегированных кристаллов (EuGa₂S₄) исследовалась при различных скоростях нагрева, уровнях возбуждения и временах возбуждения. Спектр термолюминесценции EuGa₂S₄:Er³⁺ имеет вид широкой полосы и охватывает диапазон температур 110-310К. В зависимости от скорости нагрева полуширина спектра ТЛ изменяется в интервале 30÷60К. Положение температуры T_m максимума зависит от скорости нагрева, т.е. с увеличением скорости нагрева, максимума смещается высоких температур. сторону При этом интенсивность излучения и полуширина полосы растут. Для скорости нагрева $\beta = 0,26$ К/с максимум спектра ТЛ имеет температуру Т=184К, а для скоростей нагрева 0,67К/с, 1,35К/с и 1,96 К/ссоответственно 194К, 202 и 215К. Кроме интенсивного максимума в спектре наблюдается слабый высокотемпературный пик при T_m=221К, который с ростом скорости нагрева также смещается в сторону высоких температур.

Для сравнительного анализа при скорости нагрева β =1,96К/с снят спектр ТЛ кристалла EuGa₂S₄, не содержащего Ег. Остальные условия эксперимента идентичны с условиями для ТЛ образцов EuGa₂S₄:Ег. Спектр ТЛ в этом случае состоит из четырех пиков с температурами максимума при T_{m1}=161K,

 T_{m_2} =214К, T_{m_3} =335К. Интенсивность самого интенсивного пика на этом спектре более чем на один порядок менъше интенсивности максимума ТЛ кристалла EuGa₂S₄:Er.







Рис.3. а) Спектры термолюминесценции EuGa₂S₄: Er³⁺(Er=7ат.%) при различных нагревах: 1- β =0,26K/c, 2- β =0,67K/c, 3- β =1,35K/c, 4- β =1,96K/c. б) Спектр термолюминесценции EuGa₂S₄ при скорости нагрева - β =1,96K/c

Спектр фотолюминесценции кристаллов EuGa₂S₄:Ег при различных значениях концентрации ионов Er³⁺ при 300К и возбуждении излучением лазера ЛГИ-21($\lambda_{возб.}$ =337.1нм) состоит из одной широкой полосы (дмах=550нм) и рядом узких линий в интервалах 650-700нм, 800-850нм, 850-950нм, 950-1000нм и 1500-1600нм. С увеличением концентрации Er растет интенсивность как в видимой, так и в инфракрасной области. При возбуждении излучением перестраиваемого лазера с длиной волны 976нм при различных значениях мошности и 300К наблюдается широкополосное излучение с максимумом при λ_{мах}=550нм узкополосное излучение в интервалах 650-1000нм и 1500-1600нм.

Результаты измерений ТЛ в исследуемых образцах анализированы на основе теории и модели, описанные в [3-7]. Широкие максимумы в спектрах ТЛ характерны для тройных щелечноземельних и редкоземельных халькогенидов, входящих в группу $M^{II} M_2^{III} X_4$. Например, спектр ТЛ CaGa₂S₄:Eu состоит из широкой безструктурной полосы с температурой максимума в области 130К и полушириной 80К [8]. Методом термоочисткой показано, что спектры ТЛ CaGa₂S₄:Еи обусловлены электронными ловушками с квазинепрерывным распределением уровней в интервале энергии E_c-(0,1-0,3)эВ. Эта особенность имеет место и в образцах ЕuGa₂S₄:Ег. В спектре ТЛ образца EuGa₂S₄: Er³⁺ с высоко температурной

стороны наблюдается слабый пик при 221К. Полуширина интегральной интенсивности спектра ТЛ этих образцов равна 39К. Перекрытие близкорасположенных электронных ловушек затрудняет оценить параметры отдельных уровней. Однако, сопоставление результатов ТЛ с теориями и моделями, описанными в [3-7], позволяет определить ряд параметров ловушечных уровней в EuGa₂S₄:Er. В [5] для анализа спектра люминесценнитных материалов предложен способ определения энергии активации, полуширинны ТЛ и частотного фактора и др. На основе температуры максимума T_m и высокотемпературной полуширины δ=T₂-T_m спектра ТЛ, энергии активации E_t предлагается определить следующие выражения [3]:

$$E_{t} = \frac{kT_{m}^{2}}{\delta}$$
 (1) для кинетики 1-го порядка и
 $E_{t} = \frac{2kT_{m}^{2}}{\delta}$ (2) для кинетики 2-го порядка

Зная E_t на основе уравнения (1) и (2) можно определить полную полуширину $W=T_2-T_1$ в случаях кинетика 1-го и 2-го порядка соответственно:

$$E_t = \frac{2,29kT_m^2}{W} \tag{3}$$

$$W = 2,29\delta \tag{4}$$

$$E_t = 2kT_m(\frac{1,756T_m}{W} - 1)$$
(5)

$$W = \frac{1,756T_m}{T_c} \tag{6}$$



Автор [5] показывает, что, по известным величинам W, полуширины с низкотемпературной стороны можно определить $T' = T_m -T_1$. При этом предполагается что, с низкотемпературной стороны можно найти площадь треугольника с основанием 2T' и высотой T_m . Таким образом, получаем температуру $T_0=T_m -2T_1$, при которой интенсивности TЛ равны нулю, и температуру $T_1=T_m$ -T', при которой интенсивность TЛ равна $\frac{Im}{2}$. Соответствующие температуры и параметры для анализа спектров TЛ показаны на рис 4. Принимая во внимание выше

показаны на рис.4. Принимая во внимание выше указанное, можно определить частотные факторы для следующих случаев [5]:

$$S = 2,67 \cdot \frac{\beta}{W} 10^{\frac{m}{W}} (7)$$
для кинетики 1-го порядка

$$S_{n_0} = \beta \frac{(E/kT_m)^2 \exp(E/kT_m)}{T_m (E/kT_m + 2)} (8)$$
для кинетики 2-го

Исторически впервые Урбахом предложен способ определения энергии активации по температуре максимума ТЛ по формуле:

$$E_t = A \cdot kT_m \tag{9}$$

В [10] впервые теоретически показано, что величина А в (9) равна А≈25. Дальнейшие исследования [11] показали, что в зависимости от частотного фактора, скорости нагрева и порядка кинетики релаксационного процесса А может изменяться в интервале 15÷30.

Если измерение ТЛ проводится при различных скоростях нагрева, то энергию активации можно определить по формуле:

$$\ell n \frac{T_m}{\beta} = \frac{E_t}{kT_m} + \ell n \frac{E_t}{k\overline{\sigma}_3} - \ell n \left[1 + (m-1)\frac{2kT_m}{E_t} \right] (10)$$

Если не принимать во внимание температурную зависимость эффективного частотного фактора ω_3 , а также слабое влияние третьего члена в правой части (10), то возможно определить E_t из линейной

зависимости между $\ell n \frac{{T_m}^2}{\beta}$ от $\frac{1}{kT_m}$. Когда спектр

ТЛ снимается при двух скоростях β₁и β₂, тогда для определения E_t используется следующая формула [6]:

$$E_{t} = \frac{kT_{m_{1}}T_{m_{2}}}{T_{m_{1}} - T_{m_{2}}} \ell n \frac{\beta_{1}T_{m_{2}}^{2}}{\beta_{2}T_{m_{1}}^{2}}$$
(11)

По формулам (3), (5), (11) определена энергия активации ловушек, которая в зависимости кинетики 1-го и 2-го порядка, оказалась равной E_t=0,1÷0,2 эВ.

Энергия активации ловушечных уровней также определена по методу Гарлика-Гибсона, т.е. по начальному росту интенсивности ТЛ [12] Предполагается, что независимо от характера кинетики релаксационного процесса, с низкотемпературной стороны интенсивность ТЛ с

температурой изменяется по закону $I = I_0 e^{-kT}$.

В координатах lnI от $\frac{1}{T}$ зависимость I от T носит линейный характер, наклон которого оказался равной

 $E_t=0,1\div 0,2$ эВ (рис.5).

Как выше отметили, перекрытие ловушечных уровней затрудняет по известным формулам получить разумные величины для сечения захвата и частотного фактора ловушек в кристаллах EuGa₂S₄:Er. В этом случае необходимо провести термическую очистку.



Рис.5. Зависимость интенсивности термолюминесценции EuGa₂S₄:Er³⁺ (Er=7ат.%) от температуры, при различных нагревах: 1-β=0,26K/c, 2β=0,67K/c, 3-β=1,35K/c, 4-β=1,96K/c.

порядка

И

- [1]. Charles Barthou, Paul Benalloul, Bahadur B Tagiev, Oktay G Tagiev, Said Abushov, Fatima Kazimova and Anatoly N Georgobiani. Energy transfers between Eu^{2+} and $Er^{3+} EuGa_2S_4$: $Er^{3+}J$. Phys: Condens. Matter 16 (2004) 8075-8084
- [2]. И.В.Кулешов, В.Г.Никольский. «Радиотермолюминесценция полимеров», Москва «Химия» 4. 1991.
- [3]. Ч.Б.Лущик. «К теории термического высвечивания», ДАН СССР.1955. 104. 641.1955.
- [4]. R. Chen. On the calculation of Activation Energies and Frequency Factors from Glow Curves. J. Appl. Phys. 40, 570, 1969.
- [5]. D.R.Rao. On the Analysis of Thermoluminescence Clow Pattern. Phys. Stat. sol.(a) 22, 337.(1974).
- [6]. Ю.А. Гороховатский, Г.А.Бордовский. «Термоактивационная токовая спектроскопия

высокоомных полупроводников и диэлектриков», Москва «Наука» 1991. 245.с.

- [7]. A. Mentel New Kind of Calculation of Thermoluminescence Parameters. J. Phys. Stat. sol.(a). 130, k169 (1992).
- [8]. А.Н.Георгобиани, Ю.Н.Эмиров, А.Н.Грузинцев, Е.М.Зобов, Б.Г.Тагиев, О.Б.Тагиев, Б.М.Иззатов, П.Беналулу, К.Бартоу, Й.Ванг, Сю Сююн. Термолюминесценция тиагалатов СаGa₂S₄ с примесью Еu. Кр соб. по физ ФИАН N.1, 3, 2001.
- [9]. F.Urbach // Wien.Ber. Abt. 1930-B.11a, N139, S 353-360.
- [10]. J.T.Randall, Wilkins M.N.F.//Proc. Roy. Soc.-London, 1945.-V.A184.-P.366-389.
- [11]. Boer K.W., Oberlander S.-Ann. Phys.(Germany), 1958, F.7, Bd.2 No. 3/4, s. 130-145.
- [12]. Carlik G.F.J., Gibson A.F. //Proc.Phys. Soc.-London, 1948. -N60. -P.574-590.